ネオン原子の高リュードベリ状態のシュタルク構造

天 崎 文 晶* ·松 田 良 信** 藤 山 寛**

Stark Structure of the High Rydberg States of Neon Atom

by

Fumiaki AMAZAKI*, Yoshinobu MATSUDA**, and Hiroshi FUIIYAMA**

Stark structure of the high Rydberg states of neon atom is calculated theoretically by the perturbation method. From the viewpoint of electric field measurement in the cathode fall region of glow discharge plasmas, the use of Rydberg states with medium principal quantum number $(n\sim11)$ is shown to be appropriate.

1. まえがき

1つの電子が高い主量子数をもつ軌道に励起された 状態にある原子(高リュードベリ原子)は,外部電磁 場との相互作用がきわめて大きいため,星間空間の物 理的状態を把握するプローブや,同位体分離の際の中 間体,赤外線検出センサー,非常に低速の単色電子ビー ム源として幅広い応用の可能性を秘めている¹。

薄膜形成を目的としたプラズマプロセスに利用され ているグロー放電においても,高リュードベリ原子を 利用したプラズマ中の高感度電界計測が行われるよう になり,グロー放電中の空間反応過程と表面反応との 関連についてこれまで以上により詳細な議論が可能と なりつつある。

プラズマプロセスに用いられる低圧グロー放電中の 電界計測には、レーザーオプトガルバノ法 (LOG: Laser Optogalvanic Spectroscopy)^{2,3)} やレーザー誘

起蛍光法(LIF:Laser Induced Fluorescence Spectroscopy)^{4,5)} が近年盛んに利用されている。LIF 法で は、エネルギー準位間のシュタルクミキシングにとも なう禁制遷移発光の発生を利用する。この方法では蛍 光収率が電界測定の SN を制限するので、上位準位と してはあまり大きな n(主量子数) を利用できない。 ただし, 適当な n を選ぶことにより高周波に追従し た時間分解計測が可能である。一方, LOG 法では, 高リュードベリ状態の原子を利用することにより、非 常に高感度の電界測定が可能である。高リュードベリ 原子は、外部電磁界と強く相互作用し、わずかな電界 でも容易にシュタルク効果を生じる。また、わずかな 外界の刺激で容易に電離する。さらに陰極降下領域で の電子増倍作用により、感度が増幅されるので、この 高リュードベリ原子をプローブとすれば外部電磁界の 情報を含んだ LOG 信号が感度よく得られる。さらに,

平成4年4月28日受理

^{*}大学院電気工学専攻 (Graduate Student, Department of Electrical Engineering)

^{**}電気情報工学科(Department of Electrical Engineering and Computer Science)

2本のレーザービームを交差させ二段階励起にすることで、ピンポイントの測定が可能となる⁶⁾。

本論文では、二段階励起 LOG 法を用いて、ネオン (Ne)グロー放電中の電界強度を評価する際に必要と なる高リュードベリ Ne 原子のシュタルク構造の具体 的な計算方法と計算結果を報告する。

2. 摂動法によるシュタルク構造の計算理論

シュタルク効果とは、電界によるエネルギー準位の 変化(分裂やシフト)およびそれにともなうスペクト ル線の変化(分岐やシフト)をいう。幸い、摂動法を 用いて多くの原子について1%以下の精度でシュタル ク構造を計算することが可能である⁷⁾。すなわち、電 界が加わらない場合(非摂動系)の固有値(非摂動固 有エネルギー)と固有関数(非摂動波動関数)がわか っていれば、電界が加わった場合(摂動系)の固有値 (シュタルク効果により変化した固有エネルギー)と 固有関数(シュタルク効果により混合状態におかれた 波動関数)を理論的に求めることができる。

電界が加わらない場合のハミルトニアン H。を行列 で表現すると対角行列になるが、電界が加わった場合 のハミルトニアン H=H。+H'(H'は摂動部分のハミル トニアン)には副対角成分が補正項として入ってくる。 このハミルトニアン行列を対角化すると、その固有値 がシュタルク分裂したエネルギー準位を表し、それぞ れの固有値に対応する固有ベクトルがシュタルク分裂 した各シュタルク準位の波動関数を表す。

シュタルク構造計算に対する優れた手法が Zimmerman らによって詳細に記述されている⁸)。本研究で用 いた手法は彼らの手法を簡単化したものである。主な 簡単化は,動径行列要素の数値積分を行う代わりに補 正された水素類似動径行列要素を用いたことである。

2.1 非摂動エネルギー

リュードベリ原子は,1つの電子が大きな主量子数 *n* で特徴づけられる高いエネルギー準位に励起された 原子であり,リュードベリ状態の Ne のエネルギーは 次の経験公式で与えられる。

$$E_{nl} = -\frac{R_{\rm Ne}}{(n-\delta_l)^2} \tag{1}$$

ここで $R_{Ne} = R / (1 + m_e / M_{Ne}) = 1.0973436 \times 10^5$ cm⁻¹は Ne について補正されたリュードベリ定数, $R = 1.097373177 \times 10^5$ cm⁻¹はリュードベリ定数, lは角運動量, δ_l はl軌道の量子欠損である⁹。Ne では ns と np 単位はそれぞれ1.3と0.83の大きな量子欠損 をもつので, 主量子数が異なる状態が零電界でも近く に存在する。例えば n=11d, 11f, 11g, …, 11n のリュー ドベリ準位の近くには, n=12s, 12p が存在する。Ne のような軽くない原子のシュタルク図の計算では, こ のように異なった主量子数をもつ状態を計算に含める 必要があるので, 実効主量子数 $\nu = n - \delta_l$ を用いて次 のように統一的に表現する方が便利である。

$$E_{\nu l} = -\frac{R_{\rm Ne}}{\nu^2} \tag{2}$$

ハミルトニアン行列の基底集合は非摂動ハルミトニアンの固有関数で構成される。対角行列要素は(2)式で 与えられる各準位の非摂動エネルギーである。

2.2 摂動エネルギー

摂動エネルギーは $(n-m) \times (n-m)$ のハミルトニ アン行列を対角化することにより計算される。ここで、 m は電界方向をz軸としたときの磁気量子数である。 ハミルトニアンの非対角行列要素は次式で与えられ る。

 $\langle vlm \mid eE \cdot r \mid v'l'm' \rangle$

 $=eE\langle vl | r | v'l \rangle \langle lm | \cos\theta | l'm' \rangle$ (3) ここで、e は素電荷、E は電界、 θ は電界方向を z 軸 としたときの z 軸からの傾き角である。

動径方向の積分は, Edmonds らによって報告され ている数値表を用いて,

$$\langle \nu l \mid r \mid \nu' l' \rangle = \{ a_0 \frac{3}{2} \nu_c^2 \sqrt{1 - (l_c / \nu_c)^2} \}$$
$$\sum_{p=0}^{3} \gamma^p g_p(s) \tag{4}$$

で与えられる¹⁰。ここで、 a_0 はボーア半径、 $\nu_c = 2 / (1 / \nu + 1 / \nu), l_c = max(l, l), \gamma = \Delta l(l_c / \nu_c), \Delta l = l - l_s = \nu - \nu$ である。

角度方向の積分は, 〈*lm* | cos*θ* | *lm* 〉

 $= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} Y_l^{m^*}(\theta, \phi) \cos\theta Y_l^m(\theta, \phi) \sin\theta d\theta (5)$

で与えられる。ここで $Y_{t}^{n}(\theta, \phi)$ は球面調和関数である。 $Y_{t}^{n}(\theta, \phi)$ の規格化直交性を用いて計算を行うと、

$$= \langle lm \mid \cos\theta \mid lm \rangle$$

$$= \begin{cases} \sqrt{\frac{(l'+1+m)(l'+1-m)}{(2\,l'+1)(2\,l'+3)}} \\ \sqrt{\frac{(l'+m)(l'-m)}{(2\,l'+1)(2\,l'-1)}} \end{cases}$$
(6)

となる。

また、
$$l_c = max(l, l')$$
を使うと、(6)式は

$$\langle lm \mid \cos\theta \mid l'm \rangle = \sqrt{\frac{(l_c^2 - m^2)}{(2 l_c + 1) (2 l_c - 1)}}$$
(7)

と表せる。(7)式が値をもつのは、 $\Delta l = l - l = \pm 1$ の ときのみである。

結局,以上の(4)式と(7)式を(3)式に代入して,ハミ ルトニアンの非対角行列要素は,

 $\langle vlm \mid eE \cdot r \mid v'l'm' \rangle$

$$= -eE\left\{\frac{3}{2}a_{0}\nu_{c}^{2}\sqrt{\frac{(l_{c}^{2}-m^{2})\left[1-(l_{c}/\nu_{c})^{2}\right]\right]}{(2l_{c}+1)(2l_{c}-1)}}\right\}$$
$$\times \sum_{p=0}^{3}\gamma^{p}g_{p}(s)$$
(8)

で与えられる。非対角行列要素は*l*が1異なる状態間 でのみ存在し、ハミルトニアン行列は実対称三重対角 行列になる。

2.3 シュタルク分裂線の相対強度

シュタルクスペクトルにおける各分裂線の相対強度 は、下準位からの双極子遷移の遷移確率で評価できる。 電場零での高リュードベリ状態の波動関数を ϕ_1, ϕ_2 , …, ϕ_n とし、電場により摂動を受けた後の波動関数を $\Psi_1, \Psi_2, …, \Psi_n$ とすると、 Ψ_i は ϕ_j を用いて、

$$\Psi_i = \Sigma C_{ij} \phi_j$$
 (9)
と表せる。

シュタルク効果の小さい下準位からの双極子遷移を 考える。下準位は電場の影響を受けず、その波動関数 (χ で表す)は変化しないとし、電場零での双極子遷 移は $\chi \rightarrow \phi_3$ のみが許容遷移であるとすると、摂動を 受けた準位iへの遷移確立 A_i は、

 $A_i = | \int \Psi_i^* \mu \chi d\tau |^2 = C_{3i}^3 | \int \phi_3^* \mu \chi d\tau |^2$ (1) で与えられる。ここで、 $| \int \phi_3^* \mu \chi d\tau |^2$ は電場零にお ける $\chi \rightarrow \phi_3$ の双極子遷移確率、 μ は双極子モーメント である。したがって電場内での各準位の遷移相対強度 はその固有ベクトルの χ に対応する係数の 2 乗に比 例する。

3. 数値計算

電界が加わった場合のハミルトニアン H 行列は, 動径方向積分の数値表と量子欠損データと(2)式およ び(8)式を用いて作成できる。この章では,主量子数 n=11,磁気量子数 m=0の高リュードベリ Ne 原子 のシュタルク構造の具体的な計算手順を示す。

まず対角化成分を求める。量子欠損データと(2)式 より、11s~11n、12s、12p 準位のエネルギー準位を 求めると、

 $E_{11s} = -1166.270 \text{ cm}^{-1}$ $E_{11p} = -1060.964 \text{ cm}^{-1}$ $E_{11d} = -909.\ 871 \text{ cm}^{-1}$ $E_{11f-11n} = -906.\ 896 \text{ cm}^{-1}$ $E_{12s} = -958.\ 462 \text{ cm}^{-1}$ $E_{12a} = -879.\ 500 \text{ cm}^{-1}$

となる。11s, 11p レベルは11f~11n の縮退準位より もかなり離れていて, 12s, 12p 準位がむしろ11f~11n 準位の近くに存在する。そこで,計算には12s,12p,11 d,11f,…, 11n から成る基底集合を用いた。ハミルト ニアン行列(11×11行列)の対角要素は(11)式のもの である。

つぎに,副対角化成分を求める。12s と12p 間の行 列要素 *E*_{12s,12p} の計算は以下の通りである。12s と12p 準位に関するパラメータは,

 $l = 0, \quad \nu = 10.7,$ $l' = 1, \quad \nu' = 11.17,$ $\Delta l = 1, \quad l_c = 1,$ $\nu_c = 10.9299497, \quad \gamma = 0.091491729,$ s = -0.47

で与えられるから,動径方向積分の数値表を用いて, (8)式を計算すると、12s と12p 間の行列要素 $E_{12s,12p}$ は、 $E_{12s,12p}$ =81.893 eEa_0 [J]となる。単位系を $E_{12s,12p}$ [cm⁻¹],E[V/cm]で表すと,

$$E_{12s,12p}[\text{cm}^{-1}] = 81.893 \times \frac{e[\text{C}]E[\text{V/cm}]a_0 \text{ [cm]}}{hc[\text{J}\cdot\text{cm}]}$$

= 81.893 × 4.268 × 10⁻⁵ E[V/cm]

 $= 3.495 \times 10^{-3} E[V/cm]$ (12)

ここで, ea₀/hc=4.268×10⁻⁵ [C/J]である。

以下同様に, 12p と11d, 11d と11f,…, 11m と11n に対応する副対角行列要素が求められる。

4. 計算結果

グロー放電中の電界計測に利用する観点から,主量 子数については n=9,11,1503通0,磁気量子数に ついては |m|=0,1,203通0に関して計算を行っ た。

4.1 mの違いによる変化(n=11)

高リュードベリ原子の生成にはレーザー光を利用するが、レーザー光の偏光方向と電界の方向により、作られる磁気量子数 m が異なる。 $\Delta m = 0$ は、励起光源であるレーザーの偏光方向と電界の向きが平行な場合で、 $\Delta m = \pm 1$ は、それらが互いに垂直な場合である。

二段階励起では 2 本のレーザー光を使用するので, レーザーの偏光方向に依っては $\Delta m = 2$ の遷移も可能 である。主量子数が n=11で,磁気量子数が $\Delta m = 0$, ±1, ±2についてのシュタルク分裂したエネルギー

(11)

í.



Fig. 1 (a)Theoretical Stark map for the n=11, |m| = 0 levels of Ne as a function of electric field. (b) Theoretical intensities of Stark components as a function of electric field.



Fig. 2 (a)Theoretical Stark map for the n=11, |m| = 1 levels of Ne as a function of electric field. (b) Theoretical intensities of Stark components as a function of electric field.



Fig. 3 (a)Theoretical Stark map for the n=11, |m|=2 levels of Ne as a function of electric field. (b) Theoretical intensities of Stark components as a function of electric field.

準位(a)とそれらシュタルク分裂線の相対強度(b)の電 界に対する理論計算結果を図1,図2,図3に示す。

図1(a)は、イオン芯2 p^5 (${}^2P_{1/2}$)をもつ Ne の n=11, m=0の理論的シュタルク構造の計算結果で ある。図には11d,11f,…, 11nに対応する9本の成分 が現れている。12s, 12p準位は大きな量子欠損をも ち、非摂動エネルギーがそれぞれ958.462cm⁻¹と879. 500cm⁻¹なので、この図には描かれていない。これ らの12s, 12p準位は図に示された電界では他の n=11 準位とは強く混合しない。図には2kV/cmまでの電 界についてのみ示したが、3kV/cmまでは1次のシ ュタルク効果を示すことを確認している。

図1(b)は、それぞれのシュタルク成分の予想され る2 p^5 ($^2p_{1/2}$)3p準位からの相対強度を電界の関数 としてプロットしたものである。電界がないときは、 2 p^5 ($^2p_{1/2}$)3 $p \rightarrow 2p^5$ ($^2p_{1/2}$)11dの遷移のみが観 測される。電界の効果により、11d状態のある割合が 11f, 11g,…, 11n, 12s, 12p 状態に混合されていく様子 がわかる。この割合はシュタルク分裂線のその成分へ の遷移に対する相対線強度である。図1(a)で番号を つけられた各シュタルク成分の相対線強度が,図1 (b)中にプロットされている。電界の増加とともに, 線強度が11*d*から他のシュタルク成分に分配されてい く様子がわかる。

以上の m=0の状態は、2本のレーザーの偏光を ともに電界方向と平行にすることで得られる。電界ベ クトルに対し、いずれか一方のレーザーの偏光を平行 に、他方のレーザーの偏光を垂直にすると、|m| =1の状態が生成される。電界ベクトルに対し両方の レーザーの偏光を垂直にすると、|m| = 0と2の状 態が同時に生成される。|m| = 1,2に対するシュタ ルク図の理論計算結果(図2,図3)から、|m|が 大きくなるほど、シュタルク分裂の程度が小さくなり、 11d から他の n=11準位への相対強度の移行がより小 さな電界側に移っていく様子がわかる。

2 kV/cmでのシュタルク分裂の差は、|m| = 0と|m| = 1で最大0.4cm⁻¹であり、|m| = 0と |m| = 2では最大1cm⁻¹に達する。レーザーの偏 光方向によってはこれら|m| = 0, 1, 2の混合状態が 生じ、シュタルク分裂線の同定と電界の評価が困難に なると考えられるので,電界をより簡単に評価するに は|m| = 0の配置で行うのが望ましいと考えられ る。

なお、図2の|m| = 1の場合は、12s状態は存在 しないので、計算では10×10のハミルトニアン行列を 対角化して求めている。同様に、図3の|m| = 2の 場合は、12s,12pレベルが存在せず、9×9の行列に して対角化したものである。

4.2 主量子数 n の違いによる変化(|m|=0)

磁気量子数を m=0に固定し,主量子数が n=9と 15の場合について求めたシュタルク分裂したエネル ギー準位と相対強度の理論計算結果を,図4と図5に 示す。

図4(a)のn = 9のシュタルク分裂の図をみると、こ の場合は電界に対するシュタルク分裂が、n = 11のと きより小さいことがわかる。図4(a)より、電界1.5 kV/cmのとき分裂間隔は約2 cm⁻¹であり、図4(b) より、1 kV/cm以下では各シュタルク分裂線の相対 強度比が最大で2桁近くも異なることがわかる。した がって、数 kV/cm 以上の高電界での測定に適する と考えられる。

図5は、イオン芯2 $p^5({}^2P_{1/2})$ をもつ Ne の n= 15, *m*=0のシュタルク分裂の理論計算結果とそれぞ れのシュタルク成分の予想される相対強度を電界の関 数としてプロットしたものである。この計算では15d, 15f, 15g, …, 16s, 16pから成る基底集合を用いた。 図 5 (a)には15d, 15f, 15g, …に対応する13本の線形 シュタルク成分に加えて16s, 16p の2本が現れてい る。16s, 16p 準位が図に示された電界で他の n=15準 位と強く混合している様子がわかる。この混合の結果, 電界に対する15f, 15g, …, 16s, 16p 状態の相対強度 の変化は図1(b)と比べて複雑なふるまいを示してい る。図5(a)を図5(b)と比較してよく見ると、シュタ ルク分裂成分のエネルギーが16s または16p の非摂動 エネルギーと一致するような電界では、強い混合によ りその n=15のシュタルク成分の相対強度が急激に減 少し, 16s または16p の相対強度が強められているこ とがわかる。例えば1と番号を付けた成分は1kV/ cm 付近で16p の非摂動エネルギーと交差し、このと きこの成分の相対強度は非常に低下する。電界がさら に大きくなり混合状態が解消されると,成分1の相対 強度は再生している。図5から完全な線形シュタルク 効果が生じている範囲は1kV/cm 以下の電界強度で



Fig. 4 (a)Theoretical Stark map for the n = 9, m = 0 levels of Ne as a function of electric field. (b)Theoretical intensities of Stark components as a function of electric field.



Fig.5 (a)Theoretical Stark map for the n = 15, m = 0 levels of Ne as a function of electric field. (b)Theoretical intensities of Stark components as a function of electric field.

ある。n=15のシュタルク分裂は明らかに n=11のそ れより大きいので,n=15のリュードベリ準位の利用 は、より小さな電界計測に適する。しかし、グロー放 電中の陰極降下領域の電界計測に必要なダイナミック レンジの観点からは、n~11の高リュードベリ状態の 利用が望ましいと考えられる。

5.結論

Ne のリュードベリ状態のシュタルク分裂を摂動論 を用いて計算し,電界をパラメータとしてシュタルク 分裂の様子を調べた結果,つぎのことがわかった。

- 磁気量子数 m が小さいほど、低電界においてシュタルク分裂しやすく、各シュタルク分裂線への相対遷移強度の分配もより低電界で始まる。
- 2) 主量子数 n が大きいほど,低電界において容易 にシュタルク分裂が生じ,相対強度の分配がより 低電界で始まる。ただし,n=15にもなると主量 子数の異なる他の準位とのミキシングが生じ易い ため,数kV/cm以上の電界では,線形シュタル ク効果からずれる。また,n=9の場合は,シュ タルク効果が相対的に小さくなるので,低電界(1)

kV/cm以下)では電界計測は困難で、シュタル ク効果は小さいが、高電界(数kV/cm以上)で の電界測定に十分利用できる。

3)以上より、グロー放電中の特に陰極降下領域の電 界測定には、ダイナミックレンジの観点から n~ 11が最も適する。

謝 辞

シュタルク分裂計算に関して貴重なご助言をいただ いた熊本大学助手山形氏に感謝いたします。また,本 研究に参加された電気情報工学科卒論生,池田正史氏 に感謝します。シュタルク分裂計算には本学総合情報 処理センターの科学数値計算サブルーチンを使用し た。本研究の一部は,文部省科学研究費(奨励研究 A)と御器谷科学技術財団の補助を得て行われた。

参考文献

- 1) 松澤通生, 日本物理学会誌 Vol.41, No.5 (1986) 402.
- B. N. Ganguly, J. R. Shoemaker, B. L. Preppernau and A. Garscadden, J. Appl. Phys., Vol.

61 (1987) 2778.

- E. A. Den Hartog, D. A. Doughty, and J. E. Lawler, Phys. Rev. A, Vol.38 (1988) 2471.
- 4) J. Derouard and N. Sadeghi, Opt. Commun., Vol. 57 (1986) 239.
- C. A. Moore, G. P. Davis, and R. A. Gottsho, Phys. Rev. Lett., Vol.52 (1984) 538.
- 6) D. K. Doughty, S. Salih and J. E. Lawlar, Physics Letters, Vol.103A (1984) 41.

- メシア,「量子力学2」(小出昭一郎,田村二郎訳) 東京図書(1987).
- 8) M. L. Zimmerman, M. G. Littman, M. M. Kash, and D. Kleppner, Phys. Rev. A, Vol.20 (1979) 2251.
- 9) C. E. Moore, Atomic Energy Levels, NSRDS-NBS 35 (U. S. GPO, Washington, D. C., 1971).
- A. R. Edmonds, J. Picart, N. Tran Minh and R. Pullen, J. Appl. Phys. B, Vol.12 (1979) 2781.